

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl.⁷
H05B 33/00

(11)
(43)

2003-0085508
2003 11 05

(21) 10-2003-0027036
(22) 2003 04 29

(30) JP-P-2002-00128008 2002 04 30 (JP)

(71) 가 가 2 5 5

(72) 가 180

(74)

:

(54)

EL , EL , 1 (55)
TFT(30) (33s) , (12) 2 (54) . 2
(54) (31) , . 2 (54)
(15) 3 (70) . 3 (70) (36),
(52) . 3 (70) TFT(30) (33s) .

2

, , ,

1 EL .

2 EL .

3 EL .

4 EL 가 .

5 .

< >

10 :

12 :

15 :

17 : 1

19 : 2

30 : TFT

31 :

33s, 43s :

33d :

40 : EL TFT

41 :

51 :

52 :

54 : 2

60 : EL

61 :

62 :

63 :

64 :

65 :

70 : 3

71 : 4

(Electro Luminescence: 「EL」) EL 가, CRT LCD
(Thin Film Transistor: 「TFT」) EL EL

4 EL 가 Gn (51),
Dm (52)

TFT(30)가 EL (60) EL (60) TFT(40),
TFT(30)가

EL TFT(40) (43d), PVdd가 (43s)
EL (60) (61)

TFT(30) (31) (51) Gn,
(33d) (52) Dm TFT(30) (33s) TFT(40)
(41) Dm Gn

, EL (60), (61), (65), (61) (65) (63)
(65) CV가

, TFT(40) (41) (130) (130) Dm (41)
(131) (130)

, 1,

EL Gn
T(30)가 Dm T(30)가 TFT(40) TF
가 가 (41) Dm T(30)가 TFT(40)가 (41)
가 TFT(40) EL (60) EL (60)가

5 (130) (10) , TFT(30)가 . TFT(30)
(33s), (33d) (12) (31) , TFT(30) (33s)
(12) (131) (131)

가

, , EL (60) (40)
(130)

Dm
가 (130) 가 (30)

, EL (60)
, EL (10) EL (60), EL (60)
, EL (60) (10)

(130), EL 가,
가 EL 가 가, EL

[illegible]

2 (54) , Cr, Mo (31) (70) (54) (15) , 3 (70) (70) , (36), (52) TFT(30) (33s) (139) , 2 (54) , 1 (55), 3 (70) (70) , 1 (17), 2 (19) , (65) 가 EL TFT(40) 2 (b) (43), (12), Cr, Mo (41) (43) , (43c) , (43c) (43s) (43d) (12) (43) , SiO₂ , SiN SiO₂ (15) (43d) Al Al (56) (53) (43s) (17) 1 (56) (17) ITO(Indium Tin Oxide) EL (61) 1 (17) , 2 (19) (61) , 2 (19) EL (60) , ITO (61), MTDATA(4,4-bis(3-methylphenylphenylamino)biphenyl) 1 , TPD(4,4,4-tris(3-methylphenylphenylamino)triphenylamine) (62), (Quinacridone) Bebq2(10-[h] -) (63), Bebq2 (64), (65) , EL (60) , (61) , (65) 가 가 가 (61) A-A 2 3 (b) 1 B-B 3 (a) 1 가 3 1 (70) (139) , 2 (54) , 1 (55), 3 가 (71) , 3 (70) , 가 1 (17) 4 (71) , 4 (71) , 가 2 (19) , (65) (65) 5 1 (17) , 3 (70) (65) , 4 (71) 1 (65) 2 (19) , 2 (19) , 가 1 가

EL , EL 가 가 ,

(57)

1.

2 , 1 2 2 1 3

2.

1 2

3.

1 1

4.

1 3

5.

1 2

6.

2 , 1 2 2 1 3
3 3 3 4
4 3 5 4

7.
6 ,
2

8.
6 ,
1

9.
6 ,
3

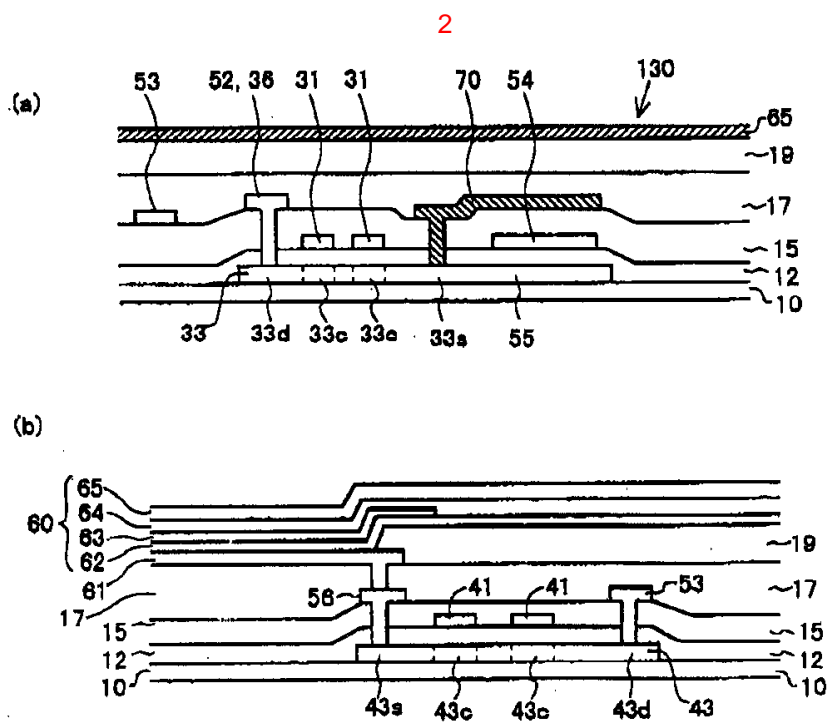
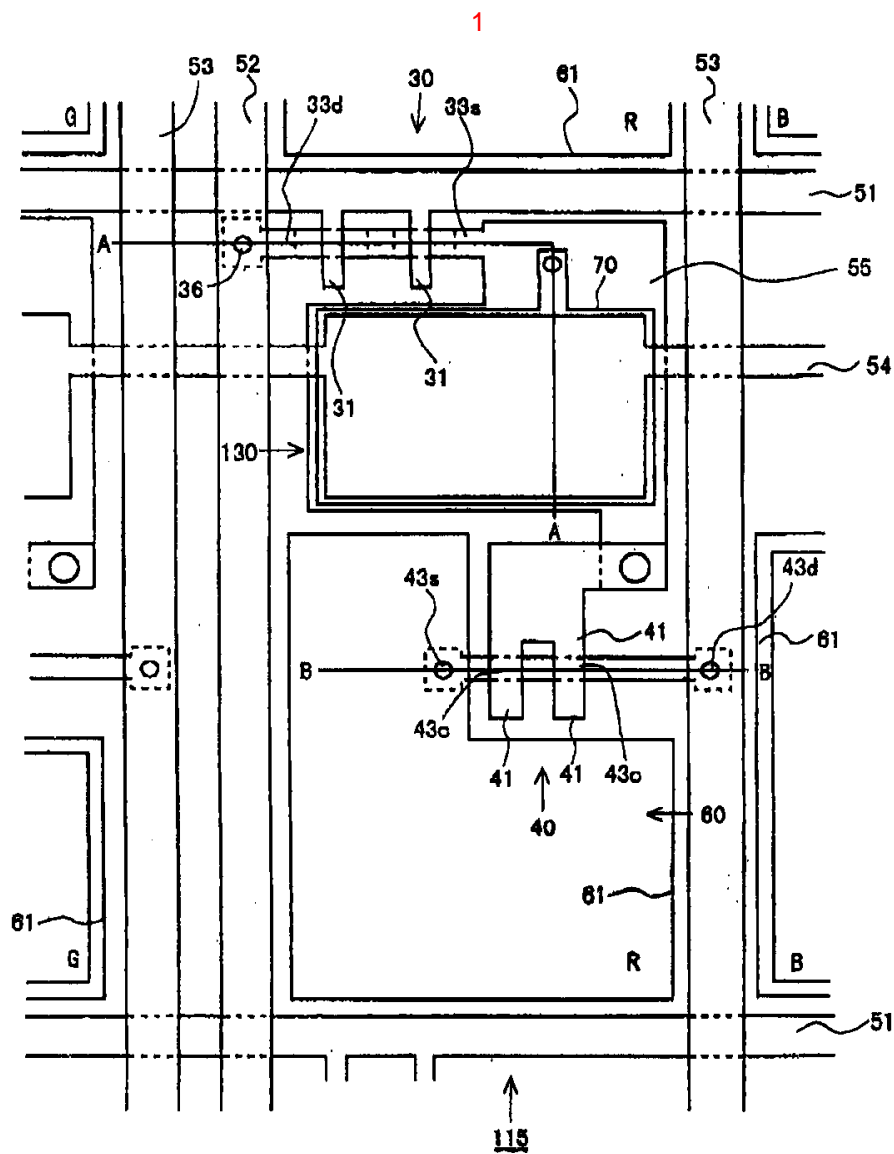
10.
6 ,
2

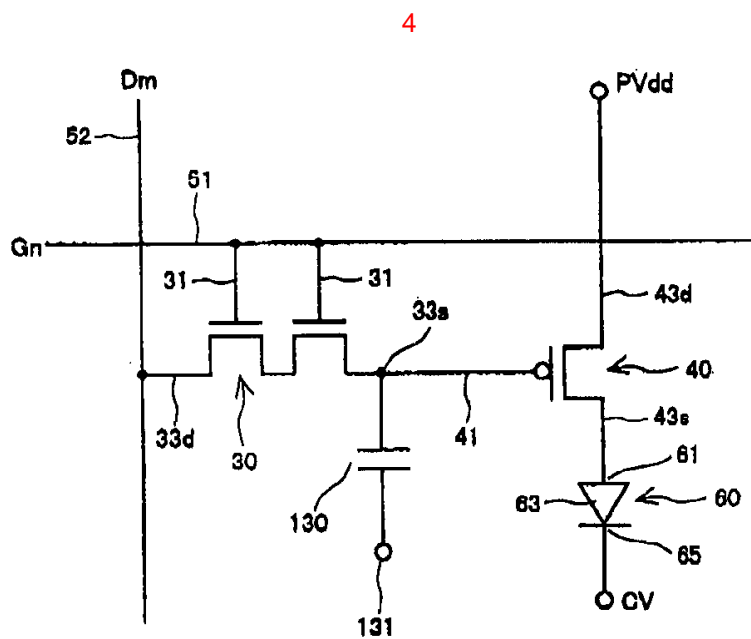
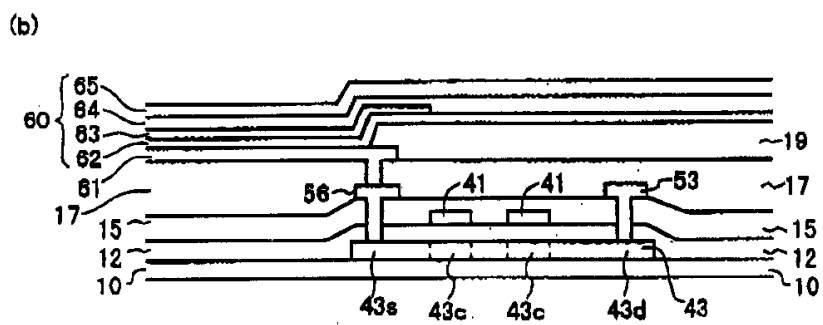
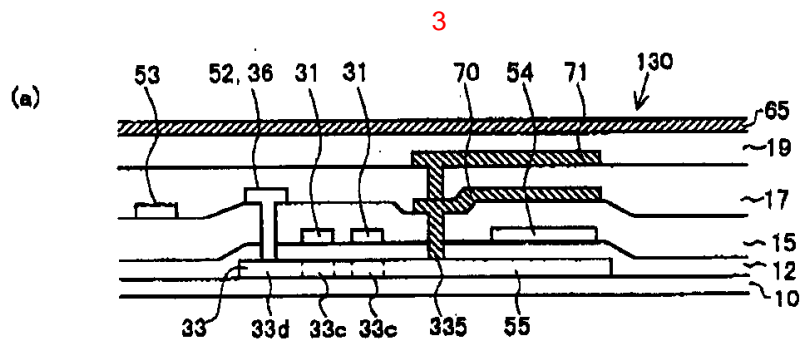
11.
6 ,
4

12.
6 ,
3 1

13.
6 ,
5

14.
6 ,
4 2





专利名称(译)	电致发光显示装置		
公开(公告)号	KR1020030085508A	公开(公告)日	2003-11-05
申请号	KR1020030027036	申请日	2003-04-29
[标]申请(专利权)人(译)	三洋电机株式会社 山洋电气株式会社		
申请(专利权)人(译)	三洋电机有限公司是分租		
当前申请(专利权)人(译)	三洋电机有限公司是分租		
[标]发明人	ANZAI KATSUYA		
发明人	ANZAI,KATSUYA		
IPC分类号	G09G3/30 H01L27/32 H01L51/50 H05B33/14 G09F9/30 G09G3/00 H05B33/00		
CPC分类号	H01L27/1214 H01L27/3265 H01L27/13 H01L27/12 H01L27/1255		
代理人(译)	LEE, JUNG HEE CHU, 晟敏		
优先权	2002128008 2002-04-30 JP		
其他公开文献	KR100527029B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

关于电致发光显示装置，用于保持提供给用于驱动的晶体管的栅极的视频信号的存储电容的形成区域减小。这是通过计划改善显示质量和改善有机电致发光显示器的寿命来完成的。并且插入栅极绝缘层（12），并且在以两种或更多种方式使用的TFT（30）的源极（33s）和第一电容电极层（55）上形成第二电容电极层（54）。在诸如第二电容电极层（54）的层中是栅电极（31），其通过相同的工艺形成。层间绝缘膜（15）夹在第二电容电极层（54）上，形成第三电容电极层（70）。在诸如第三电容电极层（70）的层处形成漏电极（36）和漏极信号线（52）。第三电容电极层（70）连接到TFT（30）的源极（33s）。电极层，平坦化绝缘层，存储电容，空穴传输层。

